

性能特点：

- 通带频段：DC~40GHz
- 衰减量：0/3dB/5dB
- 衰减精度：0.6dB
- 回波损耗：>20dB
- 芯片尺寸：1.0mmx0.5mm x 0.1mm

产品简介：

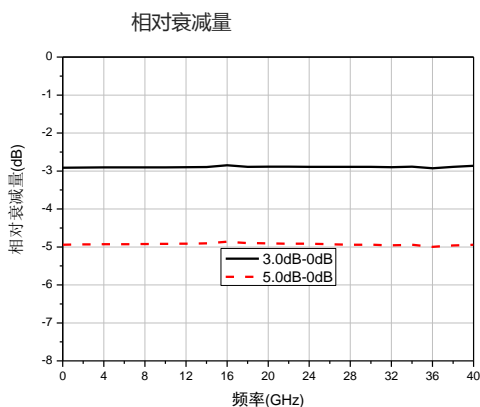
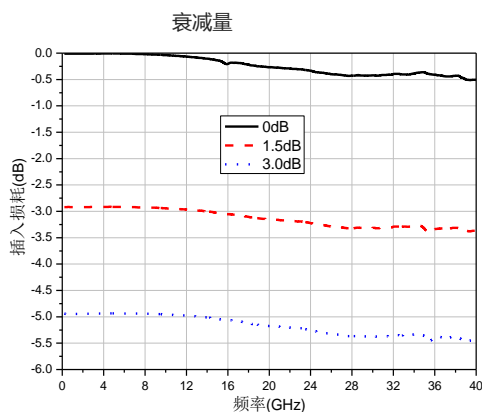
HH-AT3/0/5是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、重量轻、易集成等特点，广泛应用于改善阻抗匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理，适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

电参数：

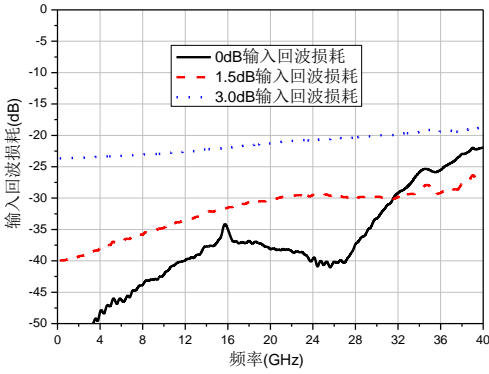
指标		最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		DC-40			GHz
衰减量	0dB	0	0	0.5	dB
	3dB	2.8	3	3.4	dB
	5dB	4.9	5	5.5	dB
输入回波损耗		20	-	-	-
输出回波损耗		20	-	-	-

使用限制参数：

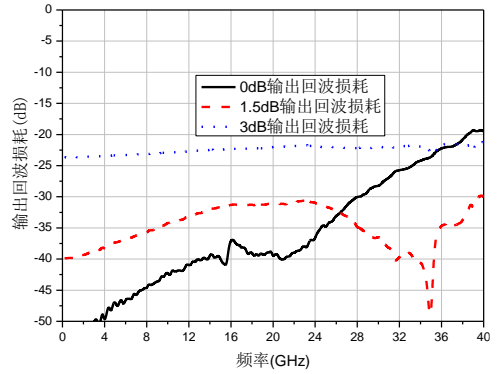
最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

典型曲线：(TA=+25°C)


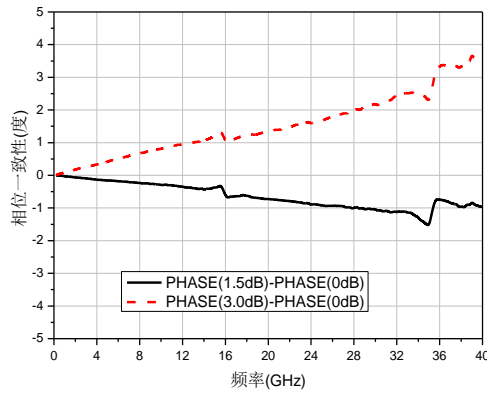
输入回波损耗



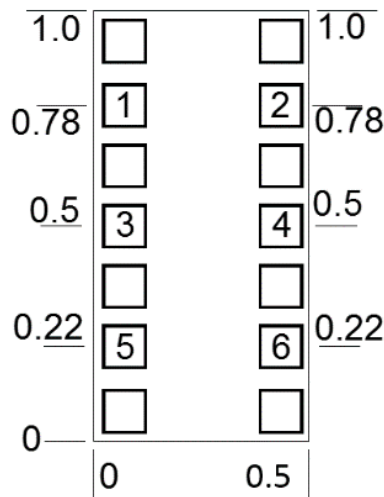
输出回波损耗



相位一致性



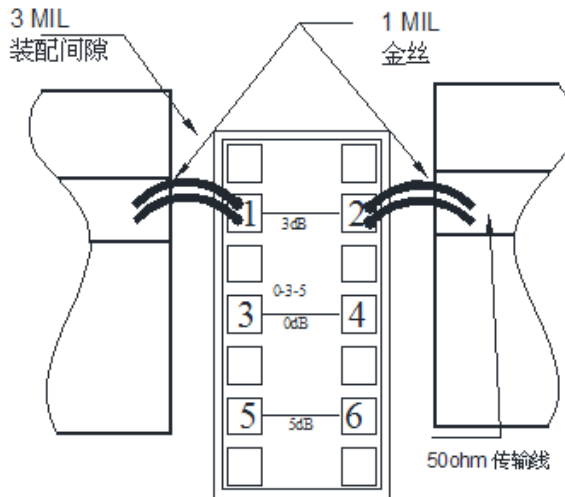
尺寸图：



键合压点定义：

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	3dB, RF _{in} , RF _{out}	3dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	5dB, RF _{in} , RF _{out}	5dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	-

建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。